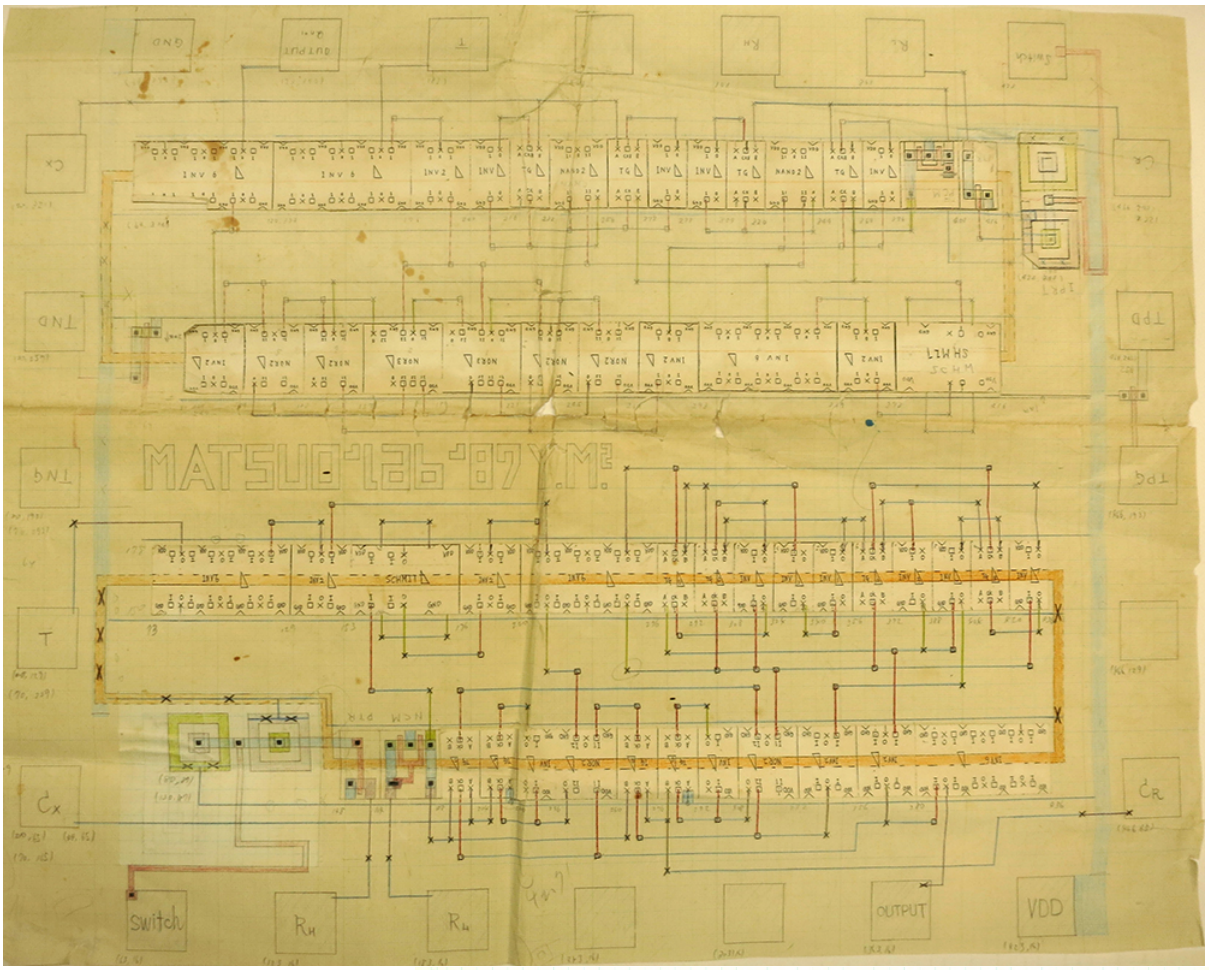
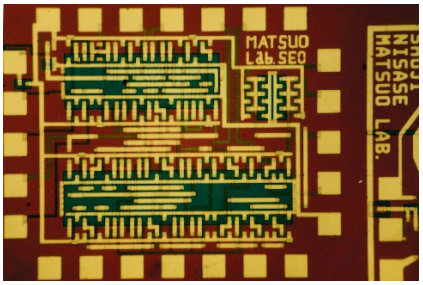
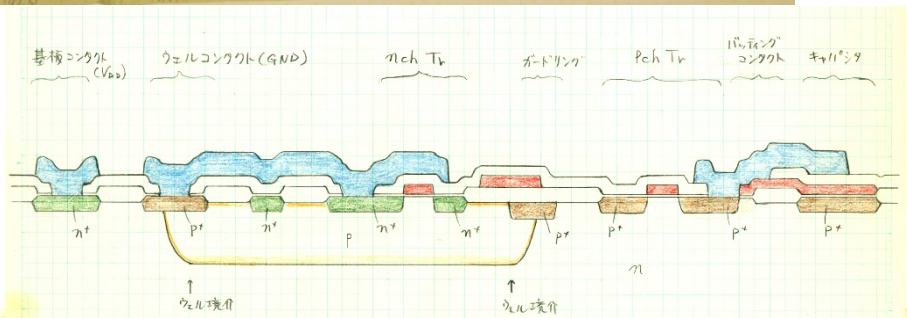
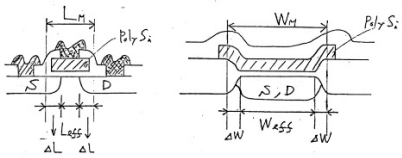
2 設計（2） レイアウト

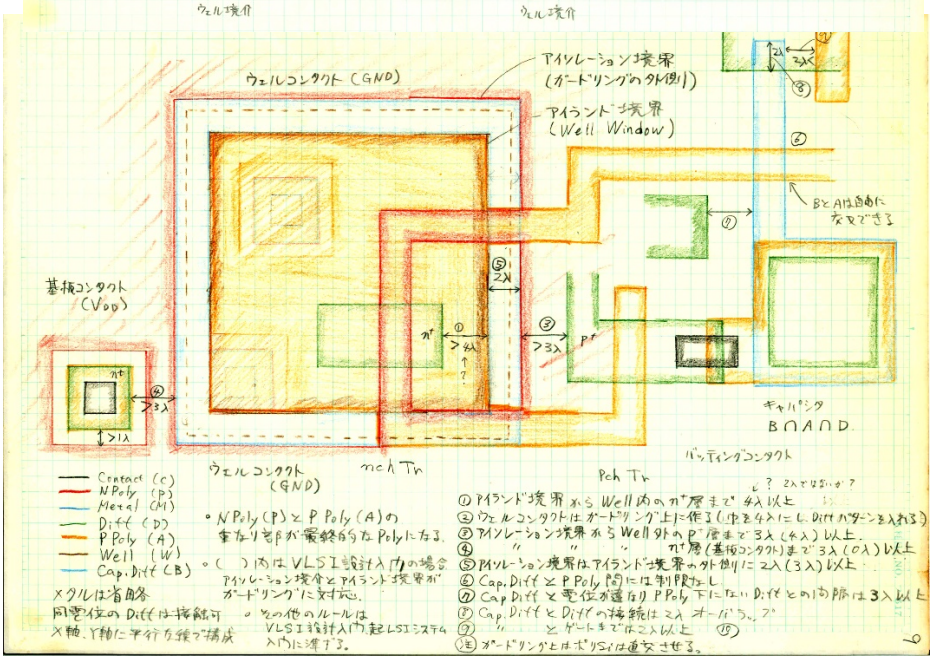








$L_{eff} = L_M - 2\Delta L$　　$W_{eff} = W_M - 2\Delta W$

パラメータ		数値 nMOS	数値 pMOS	単位
しきい値電圧 V_T		1.0	-1.2	V
実効移動度(最大値) μ_{eff}		373	149	$cm^2 V^{-1} sec^{-1}$
基板効果定数 γ		1.4	0.41	$V^{\frac{1}{2}}$
チャネル長変調効果 λ	L=5μm	0.056	0.13	V^{-1}
	L=10μm	0.012	0.022	V^{-1}
ΔL		1.83	1.7	μm
ΔW		2.64	2.14	μm
ソース,ドレイン拡散深さ x_j		2.3	2.1	μm
ゲート酸化膜厚 T_{ox}		720	720	Å

CMOS用 SPICE シミュレーションパラメータ(実測値)
(p-well ドーズ 8×10^{12} atoms/cm²)